

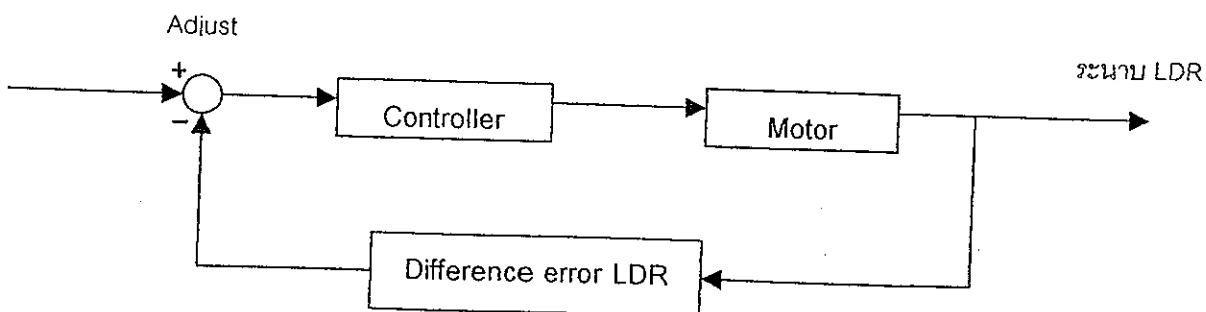
บทที่ 3

ชุดคิดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

จากความรู้ที่ว่าไปเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ที่กล่าวในบทที่สอง ทำให้ทราบถึงแนวทางที่จะนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์สูงสุด และยังเป็นความรู้พื้นฐานในการออกแบบและสร้างชุดคิดตามดวงอาทิตย์ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของชุดคิดตามดวงอาทิตย์

3.1 ชุดคิดตามดวงอาทิตย์

ชุดคิดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์คือ อุปกรณ์ที่สามารถคิดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ได้ โดยอาศัยการเปรียบเทียบค่าความต่างศักย์ระหว่างจุดสองจุดโดยใช้เซ็นเซอร์แบบ LDR ซึ่งหลักการก็คือเมื่อ LDR ทั้งสองอยู่ในระนาบที่รับแสงจากดวงอาทิตย์ได้ปริมาณเท่ากัน ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จาก LDR ทั้งสองจะมีปริมาณเท่ากัน เมื่อดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนที่ไปจะทำให้ระนาบรับแสงของ LDR ทั้งสองต่างกัน ค่าความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าของ LDR ทั้งสองตัว จะมีค่าเกินกว่าค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (error) ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของชุดคิดตามนี้ ส่งสัญญาณไปสั่งการให้มอเตอร์หมุน เพื่อบรรบ ให้ระนาบรับแสงของ LDR ทั้งสอง ซึ่งมอเตอร์จะหุ่ดหมุนก็คือเมื่อค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จาก LDR ทั้งสองมีค่าเท่ากัน หรืออยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ โดยลักษณะของการทำงานของชุดคิดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ แสดงได้ดังรูปที่ 3.1

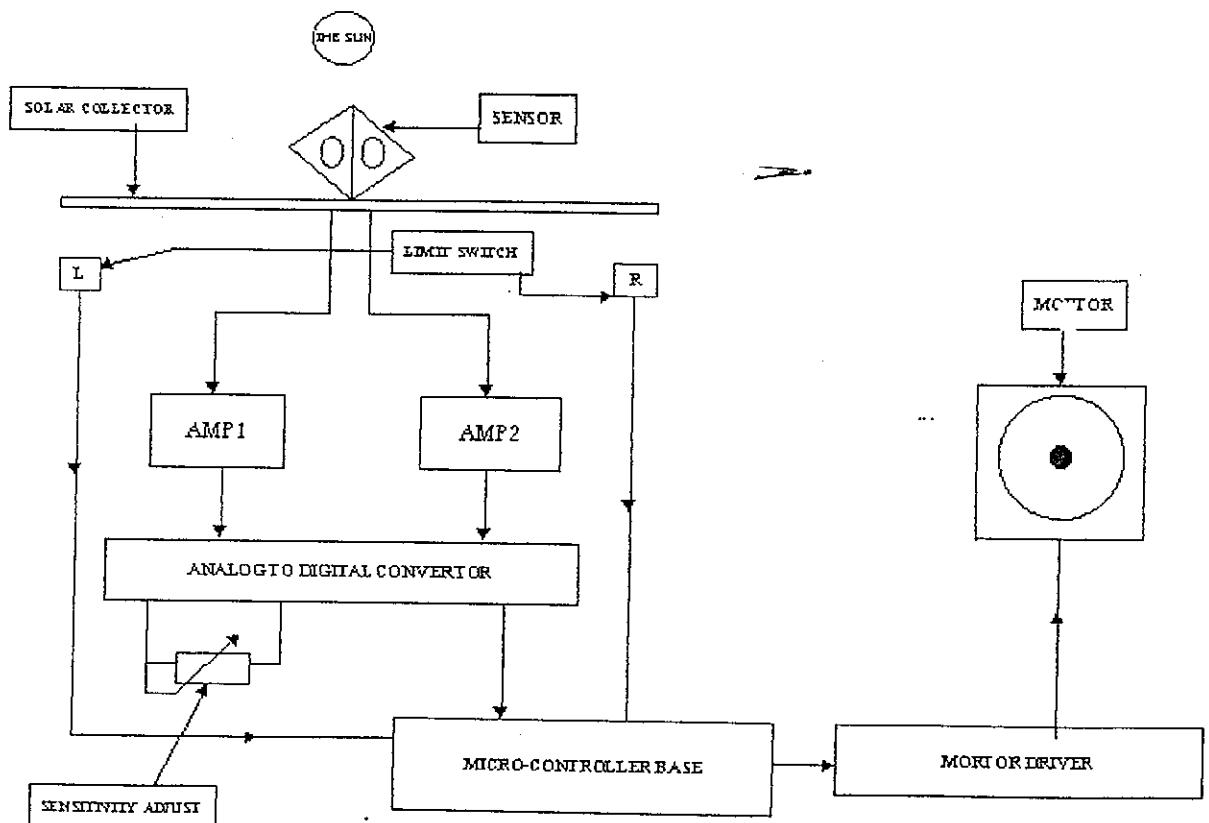


รูปที่ 3.1 แสดงแผนภาพระบบควบคุม การทำงานของชุด Controller

หลักการทำงานของระบบควบคุมกีดีอี เมื่อเข็นเซอร์แสฟ LDR ได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนค่าพลังงานความร้อนเป็นสัญญาณไฟฟ้า ในรูปของพลังงานศักย์ไฟฟ้า ซึ่งสัญญาณนี้จะผ่านเข้าสู่แมเพลิไฟเออร์เพื่อขยายสัญญาณไฟฟ้า ให้มีความเข้มสูงขึ้น จากนั้นสัญญาณไฟฟ้าถูกส่งไปยังส่วนควบคุม(Controller) เพื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าทั้งสองชุด เมื่อเกิดค่าความแตกต่าง(error) เกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ ส่วนควบคุม (Controller) จะตั้งการใหม่ออโตร์หมุนเพื่อบรรบระบบในการรับแสงของ LDR ทั้งสองตัว ให้ออปในระบบที่รับแสงได้ในปริมาณที่เท่ากัน หรืออปในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อระบบของLDR ออปในตำแหน่งใหม่ ก็จะทำให้ได้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าค่าใหม่ ซึ่งจะมีการเริ่มเปรียบเทียบอีกครั้งจนกระทั่งได้ตำแหน่งที่ค่าความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ หรืออปในช่วงที่ยอมรับได้ 牟อเตอร์กีดหุดหมุน

3.2 ขั้นตอนการทำงานของวงจรควบคุมชุดติดตามดวงอาทิตย์

ในโครงงานนี้การติดตามดวงอาทิตย์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการทำงานเพื่อให้แหงเคลื่อนที่ไปตามดวงอาทิตย์ ซึ่งลักษณะการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงดัง BlockDiagram ข้างล่าง



รูปที่ 3.2 แสดง Block Diagram ของวงจรควบคุมชุดติดตามดวงอาทิตย์

จาก BlockDiagram ผังกล่าวสามเรื่องที่จะอธิบายหลักการ และขั้นตอนการทำงานของวงจรควบคุม ได้ ตามลำดับขั้นดังนี้

3.2.1 Sensor คือ LDR1 และLDR2 จะเป็นตัวรับแสงจากดวงอาทิตย์แล้วแปลง ความเข้มแสงที่ได้รับให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้าโดยที่ค่าสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จะแปรผัน กับปริมาณ ความเข้มแสงที่ LDR ได้รับ จากนั้นสัญญาณจะถูกส่งต่อไปยังวงจรขยายสัญญาณ

3.2.2 วงจรขยายสัญญาณ ได้รับสัญญาณจากLDRทั้งสองตัวจะทำการขยายสัญญาณ ให้แรงขึ้น โดยอาศัย Adaptor ในการช่วยป้อนสัญญาณไฟฟ้า เพื่อเพิ่มขนาดสัญญาณตามความต้องการของวงจรภาค Analog To Digital Convertor

3.2.3 วงจรภาค Analog To Digital Convertor (A/D Convertor) เป็นส่วนที่จะทำการแปลงสัญญาณแบบ Analog คือสัญญาณไฟฟ้าที่ได้รับให้เป็นสัญญาณแบบ Digital ก่อนส่งสัญญาณต่อไปให้กับ Microcontroller ซึ่งจะทำการประมวลผลและควบคุมลักษณะการทำงานของชุดจำลองต่อไป

ในชุดวงจรภาค Analog To Digital Convertor นี้จะมีตัว Sensitivity Adjust ต่ออยู่ด้วย เพื่อเป็นตัวปรับความไวของระบบหรือปรับค่าความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะทำให้มอเตอร์เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งซึ่งค่าการปรับเปลี่ยนนี้คือต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณ Digital ด้วยเช่นกัน โดยใช้งานภาค Analog To Digital Convertor เพื่อที่จะส่งสัญญาณไปให้กับชุด Micro-controller เพื่อทำการเบรียบที่บันทึกสัญญาณและประมวลผลต่อไป

3.2.4 ภาคควบคุมการทำงานของระบบ ทั้งหมดใช้ Micro-controller เป็นส่วนควบคุม โดยโปรแกรมการควบคุมจะถูกบรรจุไว้ในหน่วยความจำของ Micro-controller และทำการควบคุมสั่งการระบบการทำงานทั้งหมดตามโปรแกรมที่ได้เขียนไว้ ซึ่งจะได้แสดงไว้ในการเขียนโปรแกรม Assembly MCS-51 และจากระบบวงจรควบคุมทั้งหมดนี้แล้วก็จะมีการสั่งการไปยังภาคขับเคลื่อน คือมอเตอร์เพื่อทำการขับเคลื่อนตามคำสั่งต่อไป

3.2.5 ภาคขับเคลื่อน ใช้มอเตอร์ DC ขนาด 12 Volt ในการขับเคลื่อนล้อสายพานเพื่อหมุนปรับให้ LDRทั้งสองอยู่ในตำแหน่งที่มีสัญญาณไฟฟ้าเท่ากันซึ่งในชุดจำลองนี้ใช้มอเตอร์ปีกน้ำฝนในการขับเคลื่อนเนื่องจากเป็นมอเตอร์ที่ให้ Torque สูงสามารถกลับทิศทางการหมุนได้อย่างอิสระ มีความเร็วตอบตัวเร็วต่อการควบคุม และมีความทนทานสูงง่ายต่อการบำรุงรักษา

3.2.6 LimitSwitchจำนวน 2 ตัวถูกติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนที่ไปทางซ้าย และทางขวา คือที่มุม 0 องศาและที่ 360 องศาเพื่อควบคุมและจำกัดการหมุนของมอเตอร์ไม่ให้ขับเคลื่อนชุดติดตามดวงอาทิตย์เกินองศาที่กำหนด

3.3 ระบบควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบควบคุมที่ใช้กัน ชุดจำลองการติดตามดวงอาทิตย์ในโครงสร้างแบบนี้ใช้ระบบควบคุมทั้งที่เป็น Analog และ Digital ซึ่งใช้การต่อวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไปกับ Micro controller ที่ใช้ในการเก็บบันทึกหน่วยความจำและตัดสินใจในการเคลื่อนที่ของชุดจำลอง ซึ่งวงจรควบคุม ที่ใช้ในชุดจำลองประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้

ตาราง 3.1 แสดงอุปกรณ์ของวงจรควบคุมที่ใช้ในชุดจำลอง

ชนิด	จำนวน(ตัว)
1. ตัวต้านทาน ขนาด 10 K	5
2. ตัวต้านทาน ขนาด 8.2 K	1
3. ตัวต้านทาน ขนาด 2.2 K	2
4. ตัวเก็บประจุ ขนาด 30 pF	2
5. ตัวเก็บประจุ ขนาด 10 uf	1
6. ไดโอด	2
7. ไดโอด เมล์ล์แสฟ	1
8. ตัว RELAY-DPDT	2
9. Sensitivity Adjust	1
10. Limit Switch	2
11. Switch Reset	1
12. Adaptor ขนาด	1
13. Adaptor ขนาด	1
14. Analog To Digital Convertor (เบอร์ PCF8591)	1
15. Micro-controller (เบอร์ AT89C2051)	1
16. Motor ขนาด 12 Volt	1

3.3.1 หลักการทำงานและความสามารถของอุปกรณ์ที่สำคัญในระบบควบคุม

3.3.1.1 ตัวด้านท่านแพรค่าความแสงหรือ LDR (Light Dependent Resistor) เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะการทำงานคือ ในสภาวะปกติตัวด้านท่านแพรค่าความแสง (LDR) นี้จะมีค่าความด้านท่านสูงมากอยู่ค่าหนึ่ง เมื่อมีแสงสว่างมาตักกระหบบนตัวของมัน จะมีผลทำให้ค่าความด้านท่านของตัวอุปกรณ์นี้คาดคลึงจึงอาศัยคุณสมบัตินี้ของตัวด้านท่านแพรค่าความแสงมาใช้งานในวงจรที่ทำงานด้วยแสงสว่างธรรมชาติ

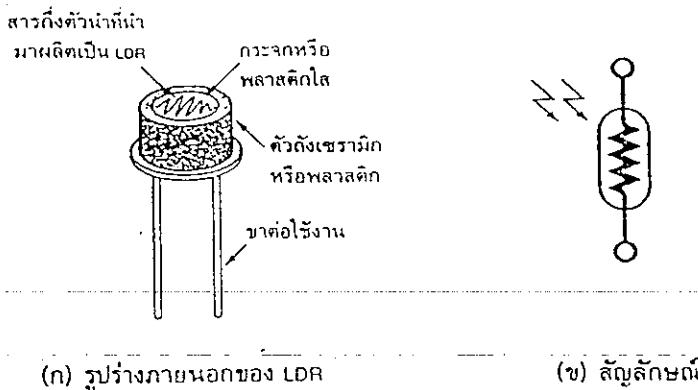
โดยทั่วไป LDR โดยส่วนใหญ่ผลิตขึ้นมาจาก แอดเมียมซัลไฟด์ (Cadmium Sulfide : CdS) หรือแอดเมียมเซเลนไนด์ (Cadmium Selenide : CdSe) อย่างโดยทั่วไปนี้โดยมีชั้บสเตรตเป็นชั้นชิลิกอน หรือเซรามิกแล้วห่อหุ้มด้วยแก้วหรือพลาสติกใส ซึ่งแก้วหรือพลาสติกในนี้เองจะทำ หน้าที่เสมือนหน้าต่างให้สามารถตักกระหบบนชั้นสารกึ่งตัวนำในรูปที่ 3.2 เป็นหน้าตาของ LDR

ถ้าอยู่ในสภาวะไม่มีแสงตกกระหบหรือมืด LDR จะมีค่าความด้านท่านที่สูงมากตั้งแต่ 500 กิโลโวลต์ จนถึง 50 เมกะ โวลต์ แต่เมื่อแสงมาตักกระหบค่าความด้านท่านจะลดลงเหลือต่ำกว่า 5 กิโลโวลต์ หรืออาจต่ำกว่าได้ ว่า อัตราส่วนความด้านท่านในช่วงมีด็อสว่างจะมีค่าประมาณ 10000 : 1 แต่อย่างไรก็ตามตัดตัวนี้ไม่แน่นอนเสมอไป ทั้งนี้ เพราะ LDR เป็นอุปกรณ์จำพวกอนโนนคิเนียร์ กล่าวคือ มีลักษณะการเปลี่ยนค่าในขณะทำงานไม่เป็นเส้น

ความไวในการรับแสงของ LDR จะแตกต่างกันตามชนิดของสารที่นำมาใช้ผลิต ถ้าเป็น แอดเมียมซัลไฟด์จะทำงานได้กับแสงที่มีความยาวคลื่น 0.6 ไมโครเมตร สภาวะในขณะที่เป็น แอดเมียมเซเลนไนด์ จะทำงานที่ย่าน 0.7-0.75 ไมโครเมตร ซึ่งนั่นก็หมายความว่า สามารถทำงานกับแสงสว่างธรรมชาติหรือแสงขาวได้

ในการเลือกใช้ LDR จำเป็นต้องทราบค่าของคุณสมบัตินางอย่างทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้งานของ LDR ผิดพลาดจนทำให้มันเกิดความเสียหาย

พารามิเตอร์ที่ต้องสนใจมีด้วยกัน 3 ตัว คือ ค่าความด้านท่านสูงสุดเมื่อไม่มีแสง มาตักกระหบค่าความด้านท่านต่ำสุดเมื่อมีแสงมาตักกระหบ แรงดันใช้งานสูงสุด สำหรับความยาวคลื่นแสงที่อยู่ในย่านการทำงานไม่มีความจำเป็นต้องคำนึงถึง เนื่องจากโดยปกตินักใช้งาน LDR กับแสงขาวหรือแสงสว่างธรรมชาติ เว้นแต่งานเฉพาะบางอย่างเท่านั้น



รูปที่ 3.3 แสดงรูปร่างกายนอกและสัญลักษณ์ของ LDR

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

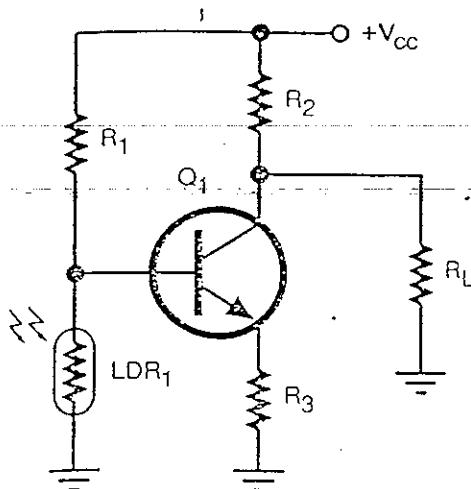
ตัวอย่างแรกใช้ในการไปแอสทรานซิสเตอร์ในวงจรขยายสัญญาณ ดังรูปที่ 3.3 ในสภาวะไม่มีแสงมากกระหบ LDR1 จะมีความต้านทานสูงมาก จึงทำให้มีกระแสไฟลัดผ่าน จึงไม่เกิดแรงดันไฟแอดต์ที่ขาเบสของทรานซิสเตอร์ วงจรจึงยังไม่สามารถทำงาน เมื่อมีแสงมากกระหบ LDR1 มีความต้านทานลดลง จึงเกิดกระแสไฟลัดผ่าน LDR1 ทำให้เกิดแรงดันต่ำคร่อมที่ขาเบส และ อินิคเตอร์ เกิดกระแสเบสไปแอตติกทรานซิสเตอร์ Q1 ทำงาน เกิดกระแสไฟลัดที่ตัวต้านทาน RL ทาง Output

ตัวอย่างที่ 2 ควบคุมอัตราการขยายของวงจรขยายสัญญาณ โดยใช้แสง ดังในรูปที่ 3.4 เมื่อยังไม่มีแสงมากกระหบ LDR1 จะมีความต้านทานสูงค่าหนึ่งทำให้วงจรมีอัตราการขยายอยู่ค่าหนึ่ง ตามความสัมพันธ์ $A_v = 1 + (R_f/R_i)$ โดยในรูปที่ 3.4 นี้ LDR1 ทำหน้าที่เป็น R_f ส่วน R_1 ทำหน้าที่เป็น R_i ดังนั้นมีแสงมากกระหบ LDR1 ก็จะทำให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไป นั่นคือ อัตราการขยายของวงจรก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

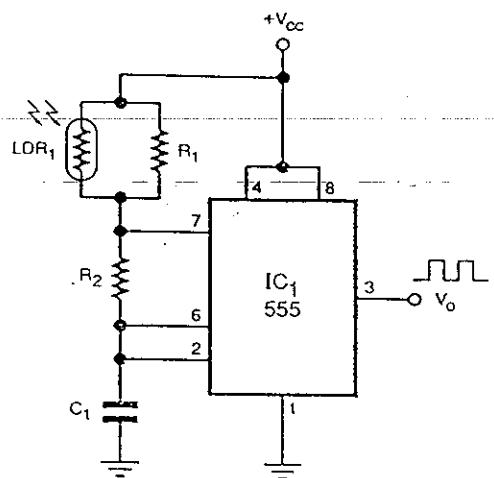
ตัวอย่างที่ 3 ควบคุมความถี่ในวงจรกำเนิดสัญญาณ โดยใช้แสง ดังในรูปที่ 3.5 ความถี่ของวงจรจะกำหนดโดยค่าของตัวเก็บประจุ C_1 ตัวต้านทาน R_1 และ R_2 เป็นไปตามความสัมพันธ์ $f = 1/((R_1+2R_2) \times C_1)$ มีหน่วยเป็น Hz แต่ที่ขา 7 ของ IC1 มี LDR1 ต่อขนานกับ R_1 อยู่ทำให้ค่าความต้านทานที่ขา 7 นี้ต้องขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนของ LDR1 ด้วย ดังนั้nmีแสงมากกระหบ ค่าความต้านทานของ LDR1 เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานรวมที่ขา 7 (หรือค่าความต้านทานรวมของ R_1 ในสูตรการหาความถี่) ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ความถี่ของวงจรเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดเป็นวงจรกำเนิดสัญญาณควบคุมความถี่ด้วยแสง

ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง หรือ LDR ที่ทำการตรวจจับแสงสว่างแล้วทำการแปรเปลี่ยนค่าความต้านทานภายใต้เงื่อนไขตามความเข้มของแสงที่ติดกระหบ ส่วนไดโอดก็เป็นอุปกรณ์

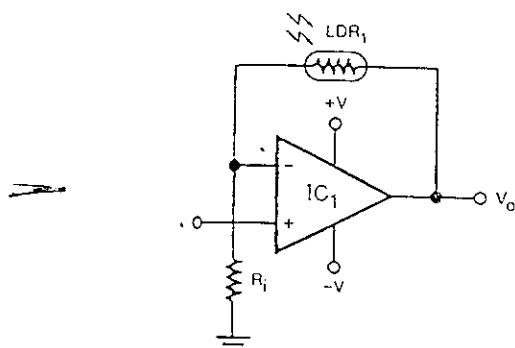
ตรวจจับแสงและมี 2 ขาเหมือนกัน โดยได้โดยจะทำงานด้วยรังสีอินฟราเรด หรือเรียกว่าไฟโตไดโอด (Photo Diode)



รูปที่ 3.4 การใช้ LDR ในการใบออก
ทราบซิสเตอร์ในวงจรขยาย



รูปที่ 3.5 การใช้ LDR ควบคุมความถี่ของวงจร
กำเนิดความถี่

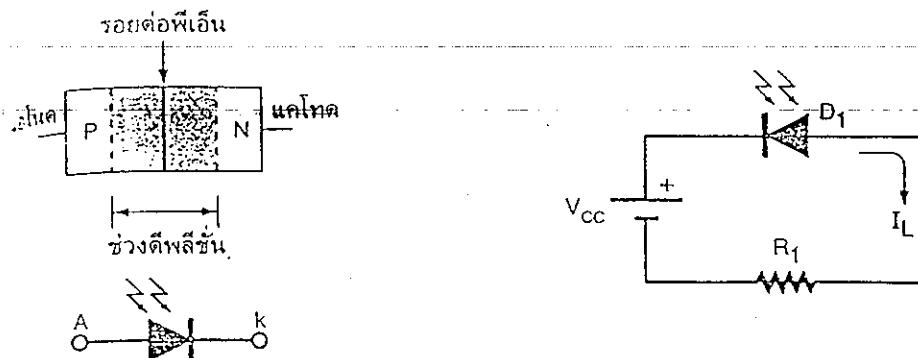


รูปที่ 3.6 การใช้ LDR ในการควบคุมอัตราการขยายของอปปแอมป์

3.3.2 โครงสร้างและพื้นฐานของการทำงาน

ไฟโตไดโอดจะมีลักษณะ โครงสร้างภายในที่คล้ายกับไดโอดธรรมดากล่าวคือ ถูกสร้างขึ้นจากการนำสารกึ่งตัวนำชนิด เอ็นและพี มาต่อ กัน มีรอยต่อ P-N และมีช่อง คิพลิชั่น อันเกิดจากการต่อขึ้นสารเหมือนกับไดโอดธรรมดากดังรูปที่ 3.6 แต่ไฟโตไดโอดจะมีลักษณะพิเศษตรงที่หากมีแสงย่างอินฟราเรดมาตกกระทบ ช่องคิพลิชั่นจะเคลบลงซึ่งทำให้อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ผ่านช่องคิพลิชั่น หรือผ่านรอยต่อพีเอ็น มาได้ ก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร

เมื่อเป็นการนำไฟฟ้าไดโอดไปใช้งานจะต้องในลักษณะให้ไฟแผลงค์กลับคือให้ไฟบวกที่ขาเดดเวย์ และให้ไฟลบุที่ขาแอลูมิเนียมตัวค้านทานต่ออนุกรมกับไฟฟ้าไดโอด เพื่อกำจัดไม่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านไฟฟ้าไดโอดมากเกินไป ดังแสดงในรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 โครงสร้างของไฟฟ้าไดโอด

รูปที่ 3.8 การจัดวงจรให้แก่ไฟฟ้าไดโอด

ในภาวะที่ไม่มีรังสีอินฟราเรดมาตกระบบทัวไฟฟ้าไดโอด จะมีผลทำให้เกิดกระแสรั่วซึ่งภายในตัวไฟฟ้าไดโอดเองซึ่งเรียกว่ากระแสแม่ดี (Dark Current) ซึ่งปกติมีค่ามากมีค่าเฉลี่ยมาก มีหน่วยเป็นไมโครแอมป์หรือนาโนแอมป์และจะขึ้นอยู่กับแรงดันที่ใช้ไฟแผลงค์กลับ ตัวไฟฟ้าไดโอด ค่าของตัวค้านทานที่นำมาต่อกำจัดกระแสและอุณหภูมิที่ใช้งานด้วย

เมื่อเกิดรังสีอินฟราเรดมาตกระบบทัวไฟฟ้าไดโอดก็จะเกิดกระแสไฟฟ้า I_L ซึ่งในวงจร ซึ่งค่าของ I_L นี้จะขึ้นกับความเข้มของแสงย่างอินฟราเรดที่มาตกระบบทัวไฟฟ้าไดโอด วัดในหน่วยของ มิลลิวัตต์ หรือ ไมโครวัตต์ ต่อตารางเซ็นติเมตร

ไฟฟ้าไดโอดถูกสร้างขึ้นจากสารกึ่งตัวนำนั่นคือ สารซิลิโคนจะสามารถทำงานได้ดีกับแสงที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 400-1100 นาโนเมตร หรือ 40-110 อังสตรอง ($1 \text{ อังสตรอง} = 10^{-10} \text{ เมตร}$)

3.3.2.1 Analog To Digital Convertor(PCF8591)

ไอซีแปลงสัญญาณ A/D และ D/A ขนาด 8 บิต ในปัจจุบันกระแสความต้องการใช้งาน “ไอซี” ประเภทแปลงสัญญาณ ขาดจากนาลอกไปเป็นดิจิตอล หรือจากดิจิตอลไปเป็นอนาลอกนั้น มีความต้องการใช้งานที่สูงมาก โดยเฉพาะในขนาด 8 บิตมักจะมีการนำไปประยุกต์ใช้งานมาก ในลักษณะงานตั้งแต่นานเด็กไปจนถึงขนาดกลางเหตุที่ เป็นเช่นนี้ก็ เพราะว่า ไอซีแปลงสัญญาณ ขนาด 8 บิต มีความละเอียดเหมาะสมและง่ายต่อการ ประยุกต์ ใช้งานโดยเฉพาะการประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมแบบถูกปิด หรือแม้กระทั่งการใช้งานในลักษณะของโมดูลเดียวที่ควบคุม

ตารางที่ 3.2 参数规格表 (PCF8591)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Supply						
V_{DD}	supply voltage (operating)		2.5	—	6.0	V
I_{DD}	supply current standby		—	1	15	μA
	operating, AOUT off	$V_i = V_{SS}$ or V_{DD} ; no load	—	125	250	μA
	operating, AOUT active	$f_{SCL} = 100$ kHz	—	0.45	1.0	mA
V_{POR}	Power-on reset level	note 1	0.8	—	2.0	V
Digital inputs/output: SCL, SDA, A0, A1, A2						
V_{IL}	LOW level input voltage		0	—	$0.3 \times V_{DD}$	V
V_{IH}	HIGH level input voltage		$0.7 \times V_{DD}$	—	V_{DD}	V
I_L	leakage current A0, A1, A2	$V_i = V_{SS}$ to V_{DD}	-250	—	+250	nA
	SCL, SDA	$V_i = V_{SS}$ to V_{DD}	-1	—	+1	μA
C_i	input capacitance		—	—	5	pF
I_{OL}	LOW level, SDA output current	$V_{OL} = 0.4$ V	3.0	—	—	mA
Reference voltage inputs						
V_{REF}	reference voltage	$V_{REF} > V_{AGND}$; note 2	$V_{SS} + 1.6$	—	V_{DD}	V
V_{AGND}	analog ground voltage	$V_{REF} > V_{AGND}$; note 2	V_{SS}	—	$V_{DD} - 0.8$	V
I_{LI}	input leakage current		-250	—	+250	nA
R_{REF}	input resistance	pins V_{REF} and $AGND$	—	100	—	k Ω
Oscillator: OSC, EXT						
I_{LI}	input leakage current		—	—	250	nA
f_{OSC}	oscillator frequency		0.75	—	1.25	MHz
Analog output						
V_{OA}	output voltage	no resistive load	V_{SS}	—	V_{DD}	V
		$R_L = 10$ k Ω	V_{SS}	—	$0.9 \times V_{DD}$	V
I_{LO}	output leakage current	AOUT disabled	—	—	250	nA
Accuracy						
OS_a	offset error	$T_{amb} = 25$ °C	—	—	50	mV
L_a	linearity error		—	—	± 1.5	LSB
G_a	gain error	no resistive load	—	—	1	%
t_{DAC}	settling time	to $\frac{1}{2}$ LSB full scale step	—	—	90	μs
f_{DAC}	conversion rate		—	—	11.1	KHz
SNRR	supply noise rejection ratio	$f = 100$ Hz; $V_{DDN} = 0.1 \times V_{PP}$	—	40	—	dB
Analog inputs						
V_{IA}	analog input voltage		V_{SS}	—	V_{DD}	V
I_{LIA}	analog input leakage current		—	—	100	nA
C_{IA}	analog input capacitance		—	10	—	pF
C_{ID}	differential input capacitance		—	10	—	pF
V_{IS}	single-ended voltage	measuring range	V_{AGND}	—	V_{REF}	V
V_{ID}	differential voltage	measuring range; $V_{FS} = V_{REF} - V_{AGND}$	$\frac{-V_{FS}}{2}$	—	$\frac{+V_{FS}}{2}$	V
Accuracy						
OS_a	offset error	$T_{amb} = 25$ °C	—	—	20	mV
L_a	linearity error		—	—	± 1.5	LSB
G_a	gain error		—	—	1	%
GS_a	small-signal gain error	$\Delta V_i = 16$ LSB	—	—	5	%
CMRR	common-mode rejection ratio		—	60	—	dB
SNRR	supply noise rejection ratio	$f = 100$ Hz; $V_{DDN} = 0.1 \times V_{PP}$	—	40	—	dB
t_{ADC}	conversion time		—	—	90	μs
f_{ADC}	sampling/conversion rate		—	—	11.1	KHz

ก
๗
๘๑๒
ก๖๔๙
๙๕๔๓

4740025
26 พ.ย. 2546

25



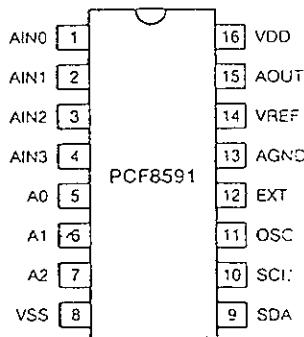
ด้วยการใช้ริ โนมติที่จ้าวศักราชแห่งจักรทิพย์เมื่อต้องถูกออกกฎหมาย ให้ใช้ในส่วนที่ขาดแคลน
แห่งลังซัพพลายหลัก ๆ จากไฟฟ้าเป็นต้น

สำเนาของสมุด

3.3.2.2 ข้อมูลทั่วไป ของ PCF 8591

ไอซีแปลงสัญญาณ PCF 8591 นี้ เป็นชิปไอซีเดียวและต้องการแหล่งจ่ายไฟที่จะใช้งาน

ลักษณะการจัดขาใช้งานของ PCF 8591 แรงดันแบบเดียวด้วย ไอซินี้เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลง
สัญญาณขนาด 8 บิต แบบซีมอสโดยมีอินพุตแบบอนาล็อก 4 อินพุต และเอาต์พุตคิจิตอล
1 เอาต์พุต พร้อมกับสามารถอินเตอร์เฟสกับอุปกรณ์ภายนอกหรือบอร์ดภายนอกในแบบอนุกรม
 I^2C บัสได้ด้วย นอกจากนั้นแล้วยังมีขาควบคุมแอคเดรส์อิก 3 แดಡเรส กีอ AO,A1 ,A2 เพื่อให้
สามารถทำการโปรแกรมแอคเดรส์ได้ทางชาร์ดแวร์ด้วยการใช้งานในแบบต่ออินเตอร์เฟสผ่าน
อนุกรม I^2C บัสนั้นทำให้สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์หรือ PCF8591 ได้สูงสุดถึง 8 ตัว โดยไม่ต้องมี
อุปกรณ์ชาร์ดแวร์อย่างอื่นต่อเพิ่มเติมแต่อย่างใด สัญญาณที่ถูกส่งออกหรือรับเข้าจาก PCF8591 นี้
ไม่ว่าจะเป็นจากขาแอคเดรส์,ขาควบคุมหรือขาข้อมูล สามารถทำการส่งผ่านสัญญาณ แบบอนุกรม
ผ่าน I^2C บัสในสองทิศทางและในสายนำสัญญาณแบบสองสายได้ ซึ่งในรูปที่ 3.8 แสดงลักษณะ
การจัดตำแหน่งขาใช้งานของ PCF8591 และในตารางที่ 3.2 แสดงคุณลักษณะทางไฟฟ้า ของ
PCF8591



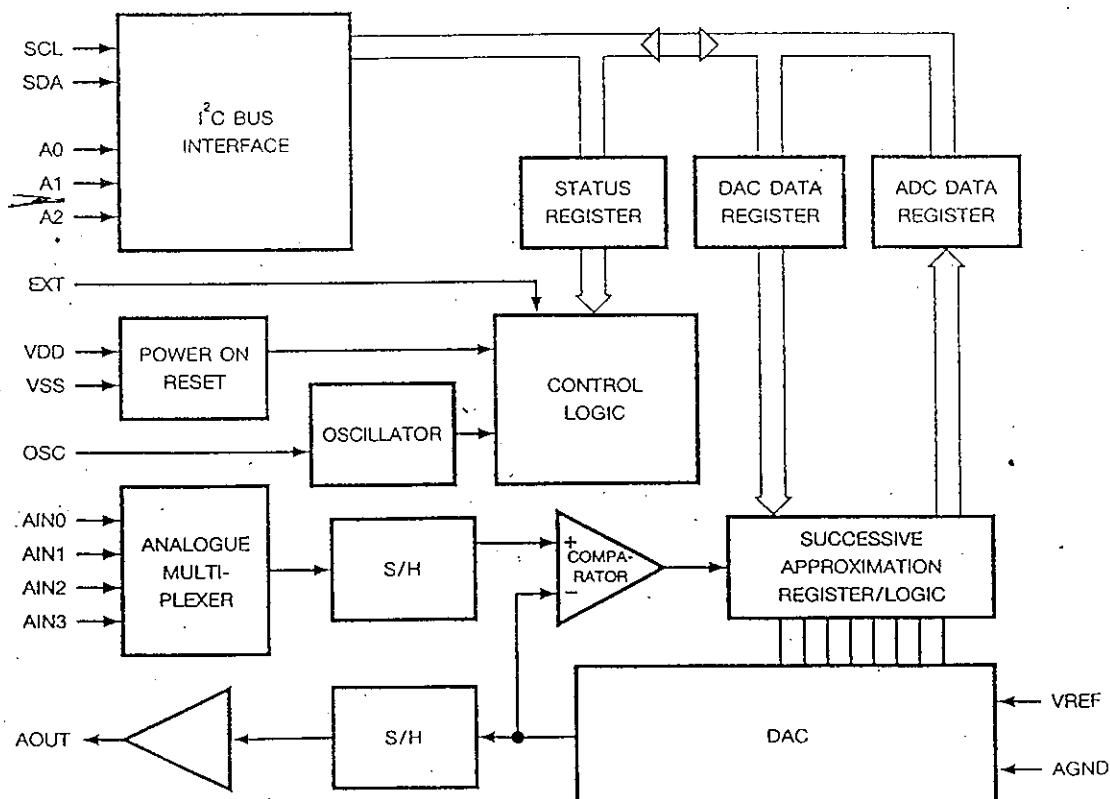
รูปที่ 3.9 ลักษณะการจัดขาใช้งานของ PCF8591

พิงก์ชันต่างๆของ PCF 8591 ประกอบไปด้วย อะนาล็อกอินพุตแบบมัลติเพล็กซ์, แทรีก
และโไฮลด์บันชิป การแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นคิจิตอลเป็นอะนาล็อกขนาด 8 บิต และ การ
แปลงสัญญาณคิจิตอลเป็นอะนาล็อกขนาด 8 บิต อีก 1 ตัว การแปลงสัญญาณสูงสุดนี้สามารถกำหนดได้

จากความเร็วสูงสุดของชานุกรม I^2C บัส ในรูปที่ 3.9 แสดงงาลีอกໄโคะแกรนภายในของ PCF8591 นอกจากนั้นแล้วคุณสมบัติเด่นอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

- ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบเดียวบ้านแรงดันใช้งาน 2.5 ถึง 6 โวลต์ดีซี
- ในสภาพสแตนด์บายกินกระแสต่ำมาก
- อินพุต/เอาต์พุตอินเตอร์เฟส แบบอนุกรม I^2C บัส
- เข้ากำหนดเดอดเครื่องสหาร์ดแวร์จาก 3 ขาใช้งาน
- อัตราการแขวนปลั๊กกำหนดจากความเร็วของ I^2C บัส
- อินพุตอะนาลอกห้อง 4 อินพุต โปรแกรมจัดให้ห้องแบบซิงเกิลเอนเดอร์หรือดิฟเฟอเรนเชียลอินพุต

- เพิ่มฟังก์ชันการเลือกเมนูได้อัตโนมัติ
- บ้านแรงดันอะนาลอกอินพุตเริ่มจาก V_{ss} ถึง V_{dd}
- บนชิปมีวงจรแทร็กและไซล์ดในตัว
- จัดเป็น D/A ได้อ่าต์พุตเป็นอะนาลอก 1 เอาต์พุต



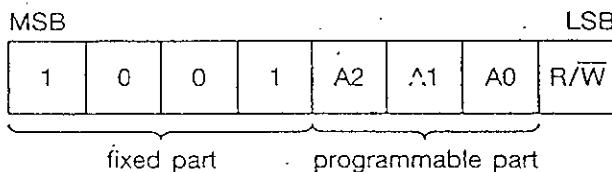
รูปที่ 3.10 บล็อกໄโคะแกรนภายในของ PCF8591

3.3.2.3 การทำงานในวงจรของ PCF8591

หน้าที่ของส่วนทำงานหลัก ๆ ของแต่ละส่วนนั้นจะพิจารณาไว้wm กับบล็อก ไดอะแกรม ในรูปที่ 3.8 ซึ่งพอยจะแยกอธิบายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญได้ดังนี้

แอคเดรสไบต์

ในอุปกรณ์ไอซี PCF8591 แต่ถ้าตัวมีอุปกรณ์ที่ใช้งานกับบันทึก ไอซี บัส แล้วจะต้อง มีการส่งสัญญาณเพื่อกำหนดตำแหน่งแอคเดรส หรือแอคเดรสไบต์มาซึ่งตัวอุปกรณ์ก่อน โดยที่ ส่วนประกอบแอคเดรสไบต์ประกอบไปด้วยส่วนที่คงที่(fixed part) และส่วนที่โปรแกรมแอคเดรส นั้นจะเขต ได้โดยการกำหนดค่าโปรแกรมแอคเดรสให้กับขาAO,A1และA2ในทุกครั้งที่มีการทำงาน แอคเดรสจะมีการส่งไบต์แรกออกไปใน ไอซี บัสโดย โอดคอลหลังจากที่มีการเริ่มต้นทำงานเกิดขึ้น และในบิตสุดท้ายของแอคเดรสไบต์ตำแหน่งของบิต อ่าน/เขียน ซึ่งจะถูกเขตหน้าที่ ตามถาวร การส่งผ่านข้อมูลเป็นหลัก ดังแสดงการจัดการแบ่งแอคเดรสไบต์ไว้ในรูปที่ 3.10



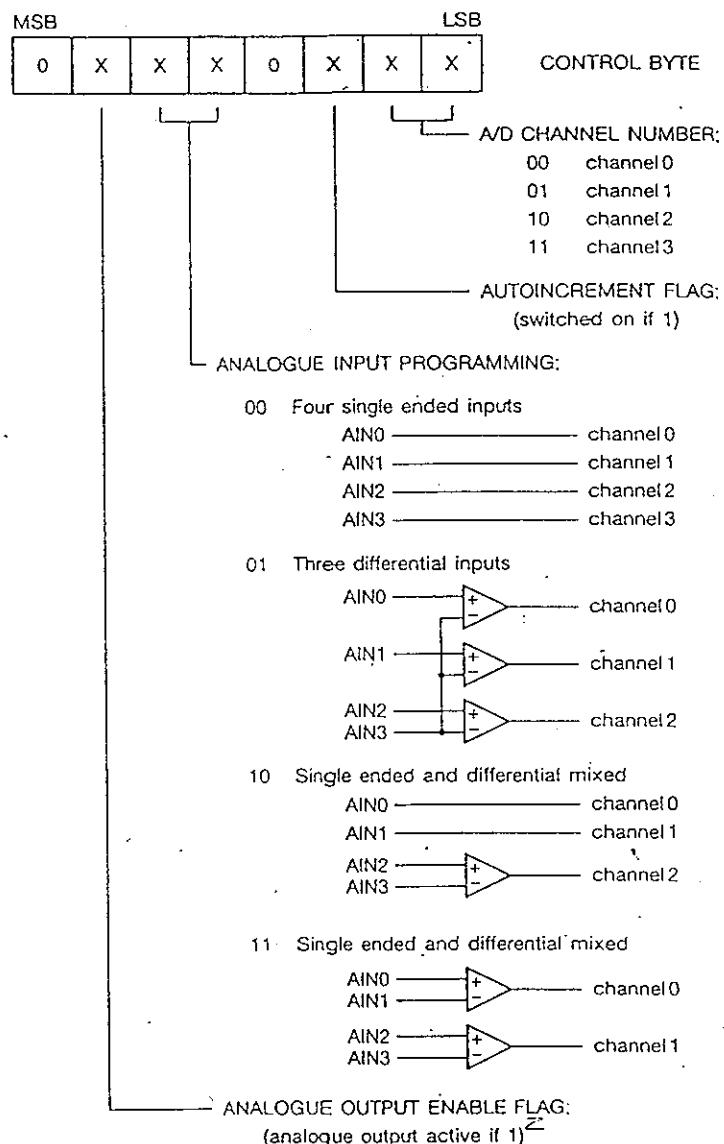
รูปที่ 3.11 ลักษณะการจัดการแอคเดรสไบต์ของไอซี

ค่อนໂທຣລັບໄຕ

ถือได้ว่าเป็นไบต์ข้อมูลอันดับสองที่จะต้องส่งเข้าไปยัง ตัวไอซี PCF8591 และทำการเก็บ บันทึกไว้ในส่วนของค่อนໂທຣລັບໄຕเตอร์ และส่วนนี้เองจะทำหน้าที่ควบคุมพิงก์ชันต่าง ๆ ของไอซี ใน 4 บิต บนสุดของค่อนໂທຣລັບໄຕเตอร์ จะถูกใช้สำหรับการอีนาเบิลอะนาลอกເອດຟຸດ และการ โปรแกรมอะนาลอกອินພຸດໃນແບບซິງເກີລເອນຄອນພຸດส່ວນອີກ 4 บิตล่างสุดจะทำหน้าที่ เลືອກອິນພຸດ อะนาลอกหนึ่งອິນພຸດທີ່ຈະສັນພັນຮັກນັກງານກຳຫົວດ້າງ 4 บิตบนสุดດ້ວຍ ดังแสดงการจัดแบ่ง ค่อนໂທຣລັບໄຕไว้ในรูปที่ 3.11 ถ้าในส่วนของบิต auto – increment flag ສູກເຊັດໝາຍເລີຂອງ ແຜນແນດ ກີ່ຈະເປັນການ incremented ແບບອັດໂນມັດທັງຈາກທີ່ເຮັດມີການ ແປ່ລົງສັງຄູານ ແບບ A/D

ถ้าในการใช้งานมีການກຳຫົວດ້າງໃນໂທຣ ໂດຍທີ່ໃຫ້ງຈອດສົຈິລເລເຕອຣ ກາຍໃນເອດຟຸດອະນາລອກະທຳການອືນເບີລແພັກໃນคອນໂທຣລັບໄຕບິຕີທີ່6 ທີ່ຈະເປັນການສູກເຊັດເກີດຈິນ ທີ່ຈະໃນຈັງກວະນີ້ ກີ່ຈະຍັງທຳໃຫ້ງຈອດສົຈິລເລເຕອຣກາຍໃນການອ່າຍຕ່ອນເນື່ອງອູ້ ແຫຼຸງທີ່ເປັນເຫັນນີ້

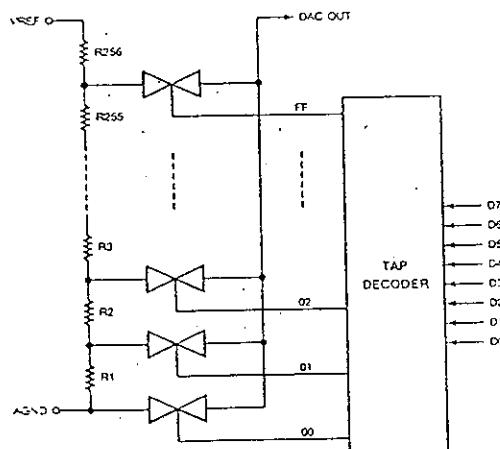
ที่เพื่อเป็นการที่จะป้องกันความผิดพลาดในการแปลงสัญญาณ จากผลของการเริ่มต้นทำงานของ ออสซิลเลเตอร์ที่มีการหน่วงเวลามากเกินไปนั้นเอง นอกจากนั้นแล้วจะนาดอกราดพูดเพลก ยังสามารถรับได้ในทุกเดือนเพื่อเป็นการลดการตื้นเปลี่ยนกำลังงาน



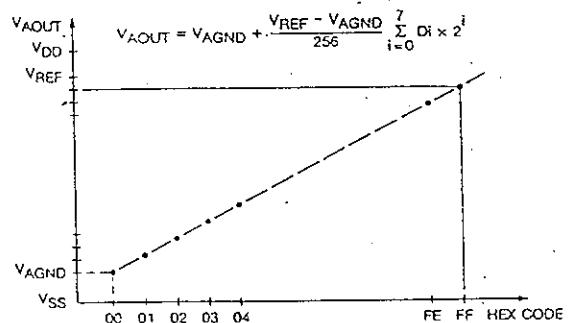
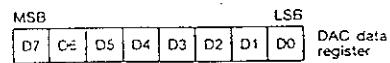
รูปที่ 3.12 ถักยละเอียดเครตในคอนโทรลไบต์

การแปลงสัญญาณ D/A

ในตัวอย่างอันดังค้าที่สามารถทำซุกน์ได้ เช่น IC ไปยัง DAC แต่จะนำไฟไปทำการเมื่อไฟใน DAC ค่าตัวเร็วจิสเตอร์ และจะทำการแปลงสัญญาณที่สัมพันธ์กันของแรงดันอะนาล็อกออกมาโดยใช้ส่วนของวงจรแปลงสัญญาณ D/A ภายในตัว IC ให้ท่วงชาระเปลี่ยนสัญญาณ D/A ภายใน IC ประกอบด้วยชุดตัวต้านทานแบ่งแรงดันที่ต้องอยู่กับแหล่งจ่ายแรงดันอ้างอิงจากภายนอกเพียงกับกราวด์อะนาล็อก ด้วยจำนวนขั้นการแบ่ง 256 ขั้น(Z256 แท็บแรงดัน) และจะถูกเลือกลำดับการแบ่งด้วยสวิตซ์ โดยที่สวิตซ์ที่ทำการเลือกลำดับขั้นการแบ่งแรงดัน จะให้อาต์พุตออกมาเพียงหนึ่งระดับ ที่ทำการเลือกและส่งค่าแรงดันนั้นไปยังส่วนของ DAC ออกทางเอาต์พุตไลน์เป็นอันดับสุดท้าย ดังแสดงบล็อกไซร์ในรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.13 หลักการแบ่งแรงดันตัวต้านทาน
แบ่งแรงดันในDAC

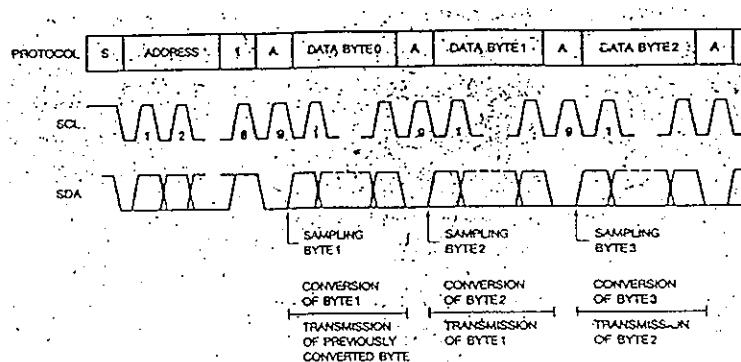


รูปที่ 3.14 คุณลักษณะของค่าแรงดันที่ได้ของ
การแปลง DAC

แรงดันอะนาล็อกเอาต์พุตจะถูกผ่านเข้าไปในบีฟเฟอร์ที่มีการปรับค่าศูนย์อัตโนมัติซึ่งเป็นบีฟเฟอร์แอนป์มีอัตราการขยายเท่ากับหนึ่ง วงจรบีฟเฟอร์แอนป์นี้สามารถควบคุมการทำงาน ON หรือ OFF ได้จากการเชื่อมต่ออะนาล็อกเอาต์พุตอินาเบิลแฟลกของคอนโทรลรีจิสเตอร์ ในช่วงที่มีการทำงาน ค่าแรงดันเอาต์พุตจะปราศจากอุժลอดเวลาที่ใบต์ข้อมูลมีการส่งเข้ามาที่ IC และค่าแรงดันเอาต์พุตที่จะถูกจ่ายออกไปทางขาเอาต์พุตอะนาล็อก Aout นั้นสามารถที่จะกำหนด หรือทราบค่าแรงดันได้จากการคำนวณในสมการที่แสดงไว้ในรูปที่ 3.13

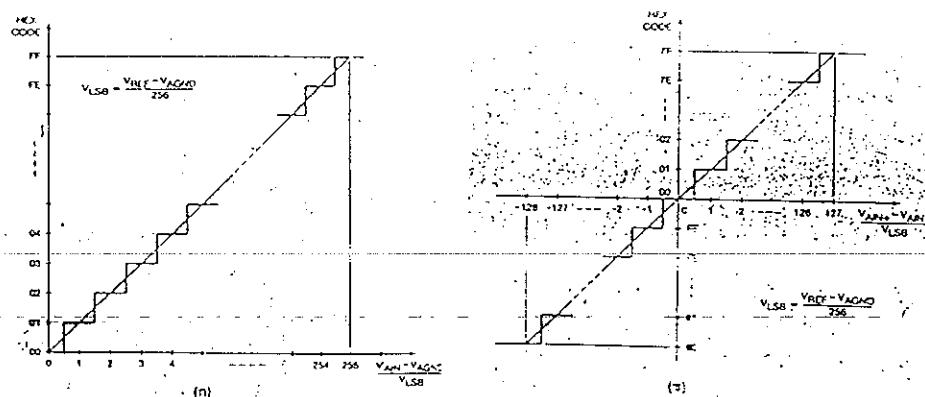
การแปลงสัญญาณ A/D

ในส่วนของการแปลงสัญญาณแบบ A/D จะอาศัยเทคนิคของการประมวลความไกส์เคียงที่เป็นลำดับต่อเนื่องของพัลส์ข้อมูลมาทำการแปลงสัญญาณ โดยอาศัยวงจรแปลงสัญญาณ D/A และวงจรอุปกรณ์อัตราขยายสูง ถูกใช้งานช่วงคราวในระหว่างวงรอบของการแปลงสัญญาณ A/D และวงรอบของการแปลงสัญญาณ A/D จะเริ่มขึ้นหลังจากที่มีการส่งเข้าไปยังแอดเดรส ในโหมดอ่านในไอซีช่วงรอบ ของการแปลงสัญญาณ A/D ก็จะถูกกระตุ้นที่ปลายของ ของพัลส์สัญญาณนาฬิกา และส่งผลลัพธ์ของการแปลงสัญญาณออกมาระดับแสดงไว้ในรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.15 ลำดับสัญญาณในแต่ละช่วงของการแปลงสัญญาณ ADC

ในแต่ละวงรอบของการแปลงสัญญาณ จะมีการกระตุ้นส่วนการทำงานที่ทำหน้าที่ เดือกดูแลและจัดการด้านอินพุตที่ต้องการ เช่น เปิดซิงค์ถูกเก็บไว้ในไอซีและในการเกิดการแปลงนี้ ก็จะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของรหัสภายในารี 8 บิต การสุ่มสัญญาณก็จะเกิดขึ้นที่ อินพุตของวงจรขยายความแตกต่างเพื่อทำการแปลงรหัส 8 บิต การสุ่มสัญญาณก็จะเกิดขึ้นที่ อินพุตของวงจรขยายความแตกต่างเพื่อทำการแปลงรหัส 8 บิตออกเป็นสองส่วนดังแสดง ลำดับขั้นของแรงดันสัญญาณที่ทำการแปลงไว้ในรูปที่ 3.15 โดยในรูปที่ 3.15(ก) เป็นการจัดวางแบบวิงเกล่อนด์อินพุต และรูปที่ 3.15(ข) เป็นแบบคิฟเฟอร์เรนเซียลอินพุตและผลของการ แปลงสัญญาณ จะถูกเก็บไว้ในตัวเรซิสเตอร์ ADC และทำการส่งข้อมูลออกไปภายนอก



รูปที่ 3.16 ก. คุณลักษณะการแปลงสัญญาณ A/D เมื่อจัดอินพุตแบบชิงเกิดอนด์
ข. คุณลักษณะการจัดอินพุตแบบ A/D เมื่อจัดอินพุตแบบดิฟเฟอเรนเชียล
ออกซิลเลเตอร์

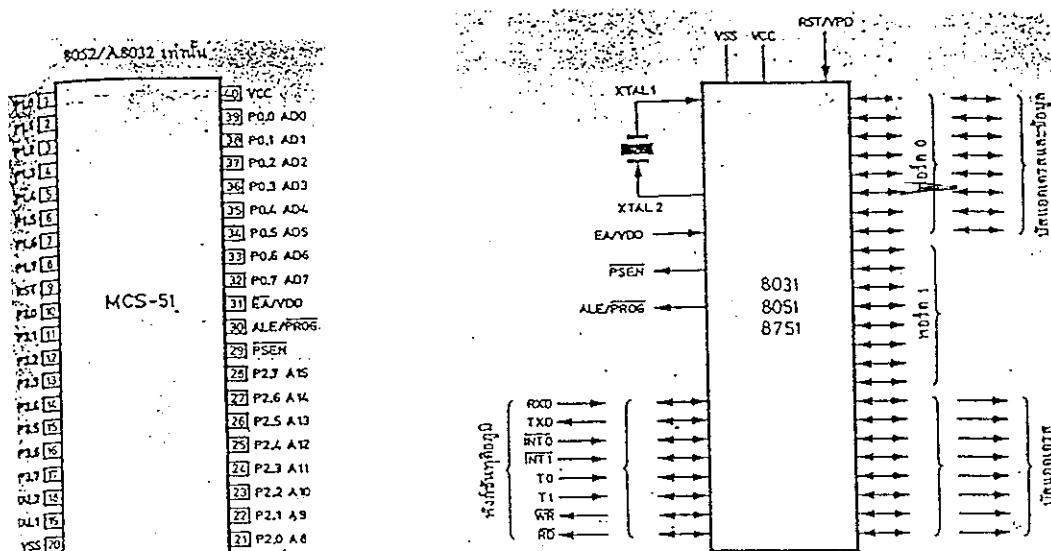
ไอซีบอร์ดนี้มีวงจรออฟซิลเลเตอร์ภายในเรียบร้อย เพื่อที่จะดำเนินสัญญาณนาฬิกาสำหรับกำหนดคงรอนของการแปลงสัญญาณ A/D และสำหรับอัตราการเคลียร์สภาวะการปรับศูนย์อัตโนมัติของวงจรบัฟเฟอร์แอมป์ ในกรณีที่ใช้งานออฟซิลเลเตอร์จากภายในไอซีขา EXT จะถูกต่อเข้ากับ Vss และขาเอาต์พุต OSC ก็จะให้ความถี่ออฟซิลเลเตอร์ออกมา แต่ถ้าขา EXT ถูกต่อเข้ากับ Vdd ขาออฟซิลเลเตอร์เอาต์พุต OSC ก็จะสวิตช์ไปยังสภาวะอินพีดเคนซ์สูง และจะย้อนให้สามารถใช้สัญญาณนาฬิกาจากภายนอกป้อนผ่านเข้ามาข้างขา OSC ได้

3.1.2.4 Micro-controller (MCS 51)

ในปัจจุบันมีไมโครคอนโทรลเลอร์เอ็มซีอีส 51 ซึ่งเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ แบบชิพเดียว (ไม่ต้องต่อ กับ อุปกรณ์ภายนอก ก็ ทำงาน ได้) จะ มี คุณ สม ควร ในการ ใช้ งาน และ เขียน โปรแกรม ควบคุม ด้วย ภาษา แม สติก ได้ โดย ไม่ ต้อง ศึกษา การ ทำ งาน ของ วง จร เนื่อง กับ ภาษา แม สเซนบลี หรือ บาง ท่า น ที่ ณ ด ภาษา แม สเซนบลี ก็ ยัง สา รา ต ใช้ ได้ เช่น กัน เอ็มซีอีส 51 นี้ เป็น อุปกรณ์ ที่ ออกแบบ มา สน อง ตาม คุณ ต้อง การ ของ ผู้ ใช้ คือ มี สาย อิน พุต และ เอาต์ พุต ภายน ใจ ด้วย พอร์ต ของ อิน พุต และ เอาต์ พุต บี ไฟ หรือ อิน เตอร์ ไฟ ส และ สาย ควบคุม อื่น ๆ ที่ ใช้ สำหรับ แยก ข้อมูล กับ เครื่อง และ ยัง มี ชุด คำ สั่ง เพิ่ม ขึ้น เป็น พิเศษ เพื่อ จัด การ ข้อมูล ตาม ที่ ยาว จ ร ต ง เวลา กับ วง จร นับ ด้วย (ปกติ วง จร นับ จะ สามารถ ทำ งาน เป็น วง จร ต ง เวลา ได้ ด้วย จ ง เรีย ก ค ว ค ุ ภ ั ก น ไป ค ื อ วง จร ต ง เวลา / วง จร นับ)

ตารางที่ 3.3 ที่ปื้นฐานการของตรรกะส�้มชีเอส 51 ซึ่งแสดงถึง จำนวนของหน่วยความจำ
วงจรตั้งเวลา : วงจรนำไปและระดับของการขออินเตอร์รัพต์

เบอร์	หน่วยความจำภายใน		ตัวเลข/บัน	อินเตอร์รัพต์ หน่วยเดียว
	ไม่แก้ไข	ซึ่งมูด		
8052AH	8K×8 ROM	256×8 RAM	3×16-Bit	6
8051AH	4K×8 ROM	128×8 RAM	2×16-Bit	5
8051	4K×8 ROM	128×8 RAM	2×16-Bit	5
8032AH	ไม่มี	256×8 RAM	3×16-Bit	6
-8031AH	ไม่มี	128×8 RAM	2×16-Bit	5
-8031	ไม่มี	128×8 RAM	2×16-Bit	5
8751H	4K×8 EPROM	128×8 RAM	2×16-Bit	5
8751H-12	4K×8 EPROM	128×8 RAM	2×16-Bit	5



รูปที่ 3.17 แสดงการจัดวงขาต่างๆ ของเอ็มชีเอส

รูปที่ 3.18 แสดงหน้าที่ของพอร์ตเมื่อ

ค่อนโทรลเลอร์ทำงานกับ
หน่วยความจำภายนอก

จากรูปที่ 3.16 และ 3.17 นั้นแสดงจำนวนขา และหน้าที่ของ 8051 ที่หมายถึงตรรกะ
เอ็มชีเอส 51 ทั้งหมด 8051, 8051 AH และ 8052AH เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานโดยการควบคุมจาก

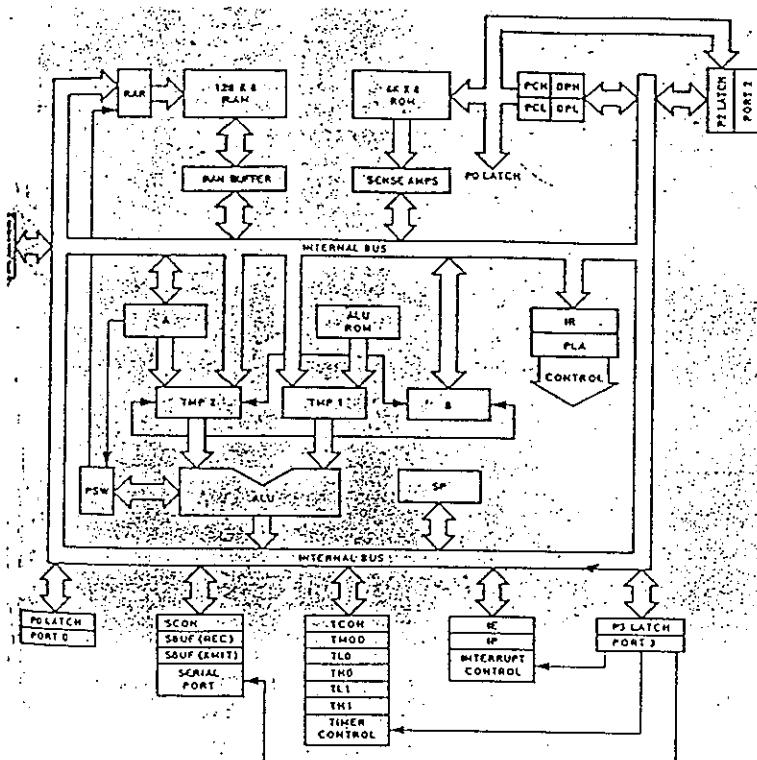
โปรแกรมในหน่วยความจำได้ทาง โปรแกรมด้วยตัวเอง
เป็นจำนวนมากซึ่งหมายถึงการผลิตเพื่อใช้งานควบคุมจำนวนมาก ๆ (8051) นั่นเป็นหน่วยความจำจำนวน 4 กิโลไบต์ที่ 8052AH จะมีหน่วยความจำเพิ่มขึ้น มีอีกหนึ่งชุดที่ทำงานกันคือชุด 8032AH ที่ใช้แทน 8051 8052AH ได้ตามลำดับ โดยไม่ต้องส่งไฟแรงงานโปรแกรมให้ เพราะเราจะเขียนทดสอบโปรแกรมด้วยหน่วยความจำภายในอกเทน (ไม่มีหน่วยความจำภายใน)

สำหรับการป้องกันการเขียนจากภายนอกก็สามารถเลือก 8751 และ 8752 ที่มีอีพร้อมภายในที่จัดสรรเวลาในการอ่านข้อมูล เพื่อกันการลอกเดิมโปรแกรม

ชนิดที่ไม่ต้องการใช้ภาษาและเชมนี้คือ 8052AH BASIC แต่ต่างจากชนิดที่นี่คือใช้ตัวเปลี่ยนเส้นช่องเป็นหน่วยความจำภายใน

ภายในหน่วยความจำ

จากรูปที่ 3.17 เป็นหน่วยความจำภายในตัว เอ็ม ซี อี ส 51 หน่วยความจำนี้แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือหน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรม และหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล หน่วยความจำแรก มีแอดเดรสที่ต่ำกว่า 4 หรือ 6 กิโลไบต์ บรรจุอยู่ในรองรับส่วนเอ็ม ซี อี ส 51 ที่ไม่มีหน่วยความจำภายใน จะใช้หน่วยความจำภายในซึ่งอาจเป็นหน่วยความจำหลัก, หน่วยความจำรอง หรือ อีพร้อมแทน



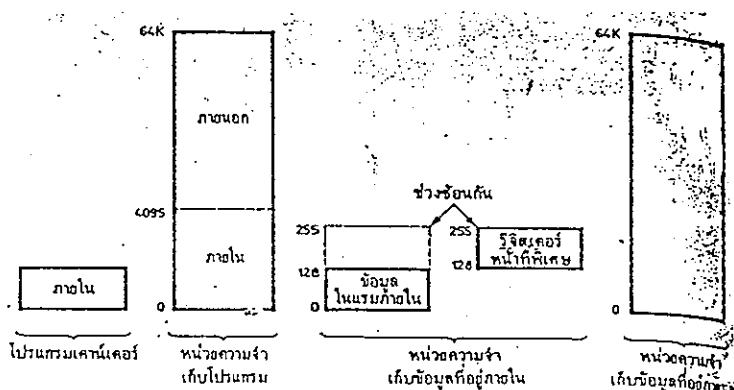
รูปที่ 3.19 โครงสร้างภายในหน่วยความจำของเอ็มซีอีส 51

ເລີ່ມຕົ້ນສະອ່ານຫຼັງຄວາມຈຳສໍາຮັບເກີນໂປຣແກຣມເຂົ້າມາເປັນການເຄື່ອງຕາມດໍາດັນສ່ວນໃຫຍ່ຄວາມຈຳສໍາຮັບເກີນຂໍ້ມູນ ຈະໃຊ້ເປົ້າທີ່ເກີນຕົ້ນແປຣ. ກາຣຄໍານ່ວມາພຸດພັນທັນທີ ກາຣ້ັດກາຮັບຂໍ້ມູນທີ່ມີໜາດ 16 ບິຕ (word) ຕາරາງທີ່ໃຊ້ກັນຫາຄ່າຕ່າງໆ ແລະ ມີກຳນົດທີ່ເປົ້າໄດ້

ໜ່ວຍຄວາມຈຳສໍາຮັບເກີນຂໍ້ມູນໃຊ້ຮ່ວມກັນຫຼັງນ່ວຍຄວາມຈຳກາຍນອກໄດ້ລົງ 640 ກິໂລໄບຕ໌ ປຶ້ງເດືອກໃຫ້ຮອນ ທີ່ຮູ້ແນມ ກໍໄດ້ແລະ ພິຈີສເຕອຣີພິເສຍທີ່ໃຫ້ໜ່ວຍຄວາມຈຳກາຍນອກຂອງແນມໄດ້ 128 ທີ່ຮູ້ອ 256 ກິໂລໄບຕ໌

ຮິຈິສເຕອຣີກາຍໃນເລີ່ມຕົ້ນ

ເລີ່ມຕົ້ນມີຮິຈິສເຕອຣີທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການໃໝ່ງານຕາມຄໍາສັ່ງຕ່າງໆ ປຶ້ງປະກອບນັ້ນດ້ວຍແອຄຄົວມູເລເຕອຣີ ຮິຈິສເຕອຣີ B ທີ່ໃຊ້ໃນການຄູນແລະ ອາຮົາ ຮິຈິສເຕອຣີ ສຕານະ ຕເຕັກພອຍນ໌ເຕອຣີ ດາວັນພອຍນ໌ເຕອຣີ (2X8 ບິຕ ທີ່ຮູ້ອ IX 16 ບິຕ) ພອຣົດໝາຍເລີຂູນຢືນພອຣົດໝາຍເລີຂູນເປັນຮິຈິສເຕອຣີແບບຄູ່ ປຶ້ງໃຊ້ແລະ ໂຮບຂໍ້ມູນຂັ້ນຕົວນຸກຮົມຮິຈິສເຕອຣີ 16 ບິຕ ທີ່ເປັນວົງຈຽດຕັ້ງເວລາແລະ ວົງຈຽດຕັ້ງເວລາຕີ 3 ຮິຈິສເຕອຣີ ຄໍາສັ່ງ ດຳຮັບຫຼັກໜ້າທີ່ພິເສຍ (ເຫັນ ກາຣອົດຮັບປັດ RTC: Read Time Clock) ແລະ ອິນພຸດ ເອົດປຸດແບນອຸກຮົມ



- INTERNAL — ໜ່ວຍຄວາມຈຳກາຍໃນ
- EXTERNAL — ໜ່ວຍຄວາມຈຳກາຍຂອບ
- PROGRAM COUNTER — ວົງຈຽດຕັ້ງເປັນການ
- PROGRAM MEMORY — ໜ່ວຍຄວາມຈຳສໍາຮັບເກີນໄປປຣແກຣມ
- INTERNAL DATA RAM — ພະບາຍໃນທີ່ເກີນຂໍ້ມູນ
- SPECIAL FUNCTION REGISTERS — ຮິຈິສເຕອຣີທີ່ພິເສຍ
- INTERNAL DATA MEMORY — ໜ່ວຍຄວາມຈຳກາຍໃນສໍາຮັບກົນຂໍ້ມູນ
- EXTERNAL DATA MEMORY — ໜ່ວຍຄວາມຈຳກາຍຂອບສໍາຮັບກົນຂໍ້ມູນ

ຮູບທີ 3.20 ໂຄງສ້າງຂອງເລີ່ມຕົ້ນ 51

จะเห็นได้ร่องสร้างภายในขาลงอิมพีลิสต์ 51 ในรูปที่ 3.19 เรายังสามารถให้มีบล็อกทาง 4 แห่ง และพอร์ตขนาด 8 บิต ตามทฤษฎี แต่ที่จริงนั้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้ หน่วยความจำภายในตัว (รวมหรือไม่)

เมื่อไม่ใช้หน่วยความจำภายในพอร์ต 0 แต่ 2 จะถูกใช้เป็นบล็อกของข้อมูลและแอคเดรส (ขอให้ดูอนุภาคไปครูบบที่ 3.16) หัวนั้นพอร์ต 2 พอร์ต บังคับใช้งานเป็นอินพุตและเอาต์พุต พอร์ต 2 ทำหน้าที่เป็นสายสัญญาณแอคเดรส A15 ... A8 ส่วนพอร์ต 0 ทำหน้าที่เป็นสายสัญญาณออก แอคเดรส A7...A0 ออกจากบิตข้อมูล D7...D0

เอาต์พุตของขา RD และ WR มาจากสายเอาต์พุตของพอร์ต 3 โดยโปรแกรมภายในใช้สัญญาณ RD และ WR เพื่อการเขียนและอ่านข้อมูลกับบิตข้อมูล ของหน่วยความจำภายนอก

ขา PSEN

ขา PSEN เป็นขารับสัญญาณสำหรับเปิดให้มีการอ่านหน่วยความจำภายนอก ถ้าสังเกตทุก ๆ รอบคำสั่งระหว่างการทำงานด้วยโปรแกรมในรอมหนึ่งอิพรอม จะเห็นว่าสัญญาณ PSEN ทำงานถึงสองครั้งเหมือนสัญญาณ ALE เพราะว่ามีการอ่านข้อมูลจำนวน 2 ไบต์ ในแต่ละรอบคำสั่งขา PSEN นี้ ไม่ทำงานเมื่อมีการเครื่องเก็บอยู่ในหน่วยความจำภายใน และถ้าหากหน่วยความจำภายนอก ไม่มีข้อมูลบรรจุอยู่ PSEN ก็จะไม่ทำงานด้วย เช่นกัน ส่วน 8052 AH BASIC ไม่ใช้สัญญาณ PSEN เลย เพราะใช้รอมภายในตัวซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแปลงภาษาเบสิก

ขา EA

เป็นขาอินพุตที่ใช้ร่วมกับแอคเดรสภายนอก โดยจะมีค่าถูกต้อง “0” เมื่อโปรเซสเซอร์ อ่านคำสั่งจากหน่วยความจำภายนอก (ปกติโปรเซสเซอร์จะอ่านหน่วยความจำภายในน้อยกว่า อ่านจากหน่วยความจำภายนอก) ขา EA ยังมีหน้าที่เป็นอินพุตสำหรับป้อนแรงดัน 21 โวลต์ เพื่อ โปรแกรมให้กับอิพรอม (สำหรับกรณีที่ใช้ 8751 หรือ 8752)

วงจรนับ / วงจรตั้งเวลา

จากตารางที่ 3.2 จะเห็นว่า 8052 มีวงจรนับและวงจรตั้งเวลาชนิด 16 บิตมากกว่า 8051 อยู่หนึ่งตัวต่อไปเราจะศึกษาการทำงานอย่างย่อ ๆ ของวงจรนับและวงจรตั้งเวลา

เมื่อทำงานเป็นวงจรตั้งเวลา รี จิสเตอร์ ที่ทำหน้าที่ตั้งเวลาจะเพิ่มค่าขึ้นหนึ่งของทุก ๆ รอบคำสั่งของเครื่องและจะนับด้วยอัตราสูงสุดที่ 1/12 ของความเร็วสัญญาณนาฬิกาของ โปรเซสเซอร์

เมื่อทำางานที่นั่งรถน้ำ ริจิสตเตอร์ว่างานน้ำจะเพิ่มขึ้นหนึ่งเมื่อมีสัญญาณป้อนให้อินพุต T0 T1 หรือ T2 (T2 มีเฉพาะ 8052) เป็นของสัญญาณขาลง คือการนับสูงสุดหรือ 1/24 ของ ภายนอกรับสัญญาณนาฬิกาของไปร์เซสเซอร์

งานนั้นและวงจรตั้งเวลา 0 และ 1 มีวิธีโปรแกรมให้ทำงานได้ต่างกันถึง 4 แบบรวมทั้งการ ทำงานเป็น 8 บิตหรือ 16 บิต และการบรรจุค่าพรีเซทหนึ่งค่าได้เองอย่างอัตโนมัติ

วงจรนับและวงจรตั้งเวลาที่ 1 เลือกโปรแกรมให้ทำงานที่ เป็นตัวกำหนดสัญญาณ ของอัตรา การส่งบิตออกไปอย่างอนุกรม สำหรับใช้ในการอินเตอร์เฟสได้

วงจรนับและวงจรตั้งเวลาที่ 2 (เฉพาะ 8052 เท่านั้น) มีการทำงานย่อย ๆ อีก 3 ชนิด

1. วงจนับ 16 บิต ที่สามารถโหลดค่ากลับคืนของอย่างอัตโนมัติ

2. วงจนับที่ของไว ชนิด 16 บิต

3. วงจรกำหนดสัญญาณของการส่งบิต เพื่อใช้อินเตอร์เฟส

ในโครคอนโอลเลอร์ทั้งหมดในคระภูด เอ็นซีเอศรี เป็นชิพที่มีอินเตอร์เฟสอนุกรม ชนิดสองทิศทางทำให้รับและส่งข้อมูลได้ในเวลาที่พร้อมกัน ตัวรับข้อมูลชนิดอะซิงโกรนัส (asynchronous receiver) มีบีฟเฟอร์สำหรับข้อมูลเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความเร็วในการสื่อสาร พอร์ตชนิดอนุกรมนี้ เราสามารถเลือกโปรแกรม เพื่อเลือกใช้การทำงานแบบใดแบบหนึ่งใน 4 แบบ ด้วยการใช้โปรแกรมควบคุมอัตราการส่งข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล

อัตราการส่งข้อมูลที่เลือกใช้ได้จะสูงถึง 19,100 บิต / วินาที ด้วยความเร็ว ของสัญญาณ นาฬิกา 1 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับใช้ในระบบเครือข่าย (networks) และ ระบบการสื่อสาร ของโทรศัพท์ หลายตัวร่วมกัน โดยเราจะเลือกความเร็วของสัญญาณนาฬิกา ด้วยวงจรนับ และวงจรตั้งเวลา

อินเตอร์ร์พ์ตและชุดคำสั่ง

8051 รับการอินเตอร์ร์พ์ตได้ 5 แหล่งส่วน 8052 รับอินเตอร์ร์พ์ตจากอุปกรณ์อื่นๆ ได้ถึง 6 แหล่ง คือ ขา INTO และ (INT1) (กำหนดให้ใช้ระดับพัลส์หรือขอบขาพัลส์ก็ได้) วงจรนับและ วงจรตั้งเวลาที่ 0 และ 1 (สำหรับ 8052 เพิ่มวงจรตั้งเวลา / วงจนับตัวที่ 2)และสุดท้ายจากพอร์ต อนุกรม เราสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของอินเตอร์ร์พ์ตได้ 2 ระดับ โดยไม่ต้องอาศัยวงจร ภายนอกช่วย แต่ละแหล่งของอินเตอร์ร์พ์ต 5 หรือ 6 แหล่งนั้น จะกำหนดเป็นเวกเตอร์ เกาะ (ตัวชี้แอดเดรส)

ดังนั้นเมื่อมีอินเตอร์ร์พ์ตเข้ามาแล้วตัวโทรศัพท์ จะกระโดดไปที่ส่วนของโปรแกรม ที่ทำงานตามวัตถุประสงค์ของอินเตอร์ร์พ์ตนั้นหลังจากเก็บข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรมคนเหตุ ลงในแซตติก ชุดคำสั่งทั้งหมดของตัวคอนโทรลเลอร์ในคระภูดเอ็นซีเอศรี แสดงไว้ในตารางที่ 3.3